

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 品田高宏 副委員長 平野博茂

幹事 池田浩也・諸岡 哲 幹事補佐 森 貴洋・小林伸彰

◎本研究会は参加費が必要になります。

エレソの技報電子化研究会に関する御案内ページ

<https://www.ieice.org/es/jpn/e-gihou-2018es/e-gihou-2018es.htm>

日時 10月17日(水) 14:00~17:25

18日(木) 9:30~15:20

会場 東北大学未来科学技術共同研究センター・未来情報産業研究館 5F (仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10. 地下鉄東西線; 青葉山駅から徒歩 2 分. <http://www.fff.niche.tohoku.ac.jp/>)

議題 プロセス科学と新プロセス技術

17日

1. [招待講演] 次世代車載マイコン対応 Fin-FET MONOS ○津田是文・斉藤朋也・長瀬寛和・川嶋祥之・吉富敦司・岡西 忍・林 倫弘・丸山卓也・井上真雄・村中誠志・加藤茂樹・萩原琢也・齊藤博和・山口 直・門島 勝・丸山隆弘・三原竜善・柳田博史・園田賢一郎・山下朋弘 (ルネサスエレクトロニクス)
2. スパッタリングプロセスを用いた新しい圧電材料とセンサへの応用 ○今泉文伸 (小山高専)・柳田幸祐
3. Low-Temperature Formation of Ohmic Contact for Si TFT Fabrication by Excimer Laser Doping with Phosphoric Acid Coating ○Kaname Imokawa (Kyushu Univ./Gigaphoton Next GLP Kyushu Univ.)・Nozomu Tanaka (Kyushu Univ.)・Akira Suwa (Kyushu Univ./Gigaphoton Next GLP Kyushu Univ.)・Daisuke Nakamura・Taizoh Sadoh (Kyushu Univ.)・Tetsuya Goto (Tohoku Univ.)・Hiroshi Ikenoue (Kyushu Univ./Gigaphoton Next GLP Kyushu Univ.)
4. Si (100) 表面原子レベル平坦化プロセスを用いた Hf 系 MONOS 型不揮発性メモリ作製プロセスに関する検討
○工藤聡也・堀内勇介・大見俊一郎 (東工大)
5. [招待講演] 低抵抗アモルファス相と高抵抗結晶相を有する $\text{Cr}_2\text{Ge}_2\text{Te}_6$ を用いた相変化メモリ
○畑山祥吾・須藤祐司・安藤大輔・小池淳一 (東北大)

18日午前

1. [招待講演] ソニー熊本工場での熊本震災からの教訓 ○鈴木裕巳 (熊本大)・上田康弘 (ソニー)
2. Thin film formation of ferroelectric undoped HfO_2 on Si(100) by RF magnetron sputtering
○Min Gee Kim・Rengie Mark D. Mailig・Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Inst. of Tech.)
3. Schottky barrier height reduction of $\text{Pd}_2\text{Si}/\text{Si}(100)$ diodes by dopant segregation process
○Rengie Mark D. Mailig・Min Gee Kim・Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Inst. of Tech.)

18日午後

4. 窒素添加 LaB_6 界面制御層によるペンタセン/ SiO_2 界面特性向上に関する検討
○前田康貴・朴 鏡恩・小松勇貴・大見俊一郎 (東工大)
5. ラマン分光法による熱電デバイス応用へ向けた Si ナノワイヤのプロセス評価
○横川 凌 (明大)・富田基裕・渡邊孝信 (早大)・小椋厚志 (明大)
6. ソースとドレインが非対称の MOSFET を用いたしきい値電圧ばらつきの統計的解析
○市野真也・寺本章伸・黒田理人・間脇武蔵・諏訪智之・須川成利 (東北大)
7. [招待講演] 熊本地域でのシリコンアイランドの推進と地震からの復興—日本の半導体産業をどう発展させるか—
久保田 弘 (熊本大)

◆応用物理学会共催

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

11月8日(木), 9日(金) 機械振興会館 [締切済] テーマ: プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般